◎ 公開特許公報(A) 平2-96921

®Int. Cl. ⁵

識別配号

庁内整理番号

④公開 平成2年(1990)4月9日

G 11 B 5/66 5/704 7350-5D 7350-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

の発明の名称 磁気記録媒体

②特 顧 昭63-249286

@出 願 昭63(1988)10月3日

⑩発 明 者 山 口 希 世 登 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

社内

⑩発 明 者 大久保 恵司 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

社内

@発 明 者 山 崎 恒 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

社内

⑪出 願 人 富士電機株式会社

神奈川県川崎市川崎区田辺新田 1 番 1 号

四代 理 人 弁理士 山口 巖

明 細 警

- 1. 発明の名称 磁気記録媒体
- 2. 特許請求の範囲
 - 1) ブラスチックまたはブラスチックとセラミックの複合材料からなる基板上に非磁性金属膜とセラミックス膜とを交互に積み重ねたパッファ脳,非磁性金属下地層,磁性層および保護調滑層をこの順に形成してなることを特徴とする磁気配録媒体。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は磁気記録要能に用いられる磁気ディスクなどの磁気配録媒体に関する。

〔従来の技術〕

第3図は従来用いられている磁気記録媒体の模式的な要部構成断面図を示したものである。第3図の磁気記録媒体は A.ℓ-Mg 合金 高板 1 の上に非磁性金属 医体層 2 を被優し、この非磁性金属 医体層 2 上にさらに非磁性金属下地暦 3 を介して例えば Co-Ni-Cr 合金 薄膜の磁性層 4 を被優し、磁性

層4 止に保護機構層 5 を設けてあり、基板 1 に非 磁性金属基体階 2 から保護機構勝 5 までをこの符 号風に概み重ねたように構成したものである。

このように解成された磁気記録媒体は製造過程で落板1を所定の面租さ、平行度および平而度に仕上げ、非磁性金質番体層2はNi-P合金を無低解めっきもしくは器板1目体をアルマイト処理することにより形成するのが好ましく、いずれも所定の硬さを必要とし、裂面は微被的研磨を行なって所定の面積度まで仕上げる。非磁性金属下地層3は一般にCrを用いてスパック形成し、引続きCo-Ni-Cr合金などの磁性層4, さらばかーポンもしくはSIO2などの保護機構 5を連続的にスパックして被模する。

して形成したものの代裂的な母気特性として保田 カ Hc は 900 Oe である。

以上のような血気配鉄鉄体は結特性の向上とと もに近年ますます軽量化とコストの低速に対する 数求が高められている。

(発明が解決しようとする課題)

配数媒体の軽量化とコスト低放に対して考慮すべき点は 監板材料の選択である。 すなわち、A8-Mg 合金を 監板に用いているために、この上に使い NI-P 履を設けねはならず、 誘板面と Ni-P 履の殺面研磨加工に多大の時間を 要し、このたりとがコストに大きな比略でするためには、 所定のでて、 この加工工数を短縮するためには、 所定の面徴いので、 大幅な工数値以に仕上げなければならないので、 大幅な工数値以て不可能であってストの低級には限界があり、 A8-Mg 合金を用いる限り多くを期待することができない。

一方基 板材料の選択に関しては配録媒体の経量 化も含めて、プラスチックもしくはプラスチック とセラミックの複合材料を用いるのが有限である。

金崎膜のクラック発生を防止することができる構造を打する歴気記録媒体を提供することにある。 〔繰りを解決するための手段〕

本発明の磁気記録媒体はブラスチックなどの非磁性器板上に、非磁性金属膜とセラミックス膜とを交互に積み重ねたパッファ 層、非磁性金属下地層、磁性層および保護機構磨をこの値にスパッタ 形成したものである。

〔作用〕

てれらの材料は A8-M8 合金より 低く、金型を用いて成形することができるので、金型の袋面を高精度に加工しておくことにより、成形をの袋面研磨を行なうことなく十分に良好な削組さや平行度が得られるという利点があるからである。

本発明は上述の点に始みてなされたものであり、 その目的は低気配録媒体をより戦量とし、コスト を低放するためにプラスチックまたはプラスチッ クとセラミックの複合材料を用い、しかもスパッ タ方式により形成され、良好な磁気特性を有し、

描するだけで応力を吸収または緩和する役割を果 たすことができない。

そこで本発明のように、バッファ暦を形態の異 なる膜を多層に積み重ねたものとして形成し、応 力伝播を遅らせ、それぞれの膜の界面において応 力段和を分担させることにより、全体の応力侵利 に寄与させることが可能となる。 しかもこれらの 膜は低気配録媒体の製造工場上、成膜が容易であ ることに加えて、成願時の条件改定によって形態 の異なる膜を交互に横層できるものでなければな らない。このようなことから、バッファ間として、 非磁性金属膜とセラミックス膜との引み合わせは 好適であり、これらを交互に槙盾すると、パッフ ァ魔全体として所定の厚さの中に形態の異なる膜 が一つ健きに摂み直ねられたものとなり、このパ . ッファ 膳が ブラスチック 基 板 と 金 輿 下 地 脳 と の 熱 膨張係数の大きな差によって生する内部応力を破 和し、金餌下地層のクラック発生を防止するよう に作用する。

() 施 例)

以下本発明を奥施例に基づき説明する。

第1図は本発明により得られた母気配録媒体の 模式的な製部構成断面図を示したものであり、第 3図と共通部分を同一符号で表わしてある。第1 図は第3図と基本的な構成は同じであるが、第1 図が第3図と異なる点は基础1aにプラスチック を用い、基板1aと非磁性金額下地層3との間に、 非磁性金換器体層2ではなく、ベッファ層<u>6</u>が介 在するように構成したことにある。

この磁気配数媒体はまず基板材料にポリエーテルイミド樹脂の商品名クルテム 1000 を用い、所足の設面精度をもった金型により畝形 して基板1a を作製し、この基板 1a 上に非磁性金減膜 6a とセラミックス膜 6b を交互に積層してなるパッファ層 6 を形成するが、第 1 図では便宜上これら寝 膜の積層数を 6 層とした場合で示してあり、非磁性金真膜 6a とセラミックス膜 6b の 膜厚はいずれら 50 Λ である。 さらにこのパッファ層 6 上にC C の非磁性金属下地層 3 を 2000 Λ 。 Co-30 at % Ni-7.5 at % Cr 6 金の磁性層 4 を 500 Λ 。 n

形成した。また比較のために、Crターゲット、SICターゲットのDCスパックをそれぞれ単独で行なった非磁性金異版 6 a のみと、セラミックス践 6 b のみのパッファ B を作製し、一方ポリエステル樹脂と複像カルシウムとの複合材料からなる 弦板も作製した。

さらにパッファ h 6 上に似次形成する非磁性金 関下地局 3 の Cr , 磁性層 4 の Co - Ni - Cr 合金お よび保護調消層 5 のカーボンの成蹊をいずれも DC スパッタ法により次の条件により行なう。

燕板ຝ度:80℃以下

以 料: Crターゲット, Co-Ni-Cr 合金ターゲット, Cターゲット, Ar ガス

成以近力: 10 mTorr

次に以上のごとくして得られたそれぞれの田気 記録媒体について金国膜に発生するクラック数と 耐食性能について比較を行ない、その結果を第2 図(a),(b)に示す。第2回(a)は段朝を非歴性金属下 地層3のCrに発生する単位断段(st) あたりの1 pm以上のクラック数とし、機軸をバッファ暦 6 ンの保護協計層 5 を 500 Å 同一反応権内で連続的にスパッタ形成することにより第 1 図の磁気配象 鉄体を構成したものである。

ここで非低性金段膜 6 a の例えば G とセラミックス膜 6 b の例えば SIC は 次のようにして形成される。 すなわち、スパック 袋 関により 密板 温度 W で以下とし、 Cr ターケットを用い、 Ar ガスを B 入 して 成 膜 圧 力は 3 ~ 5 m Torr と いう 条件で D C スパック 法で非 田性 金 四 膜 6 a を 形 成 した 後 クーケットの み SiCを 用い、 その他の 条件 は全く 同じて セラミックス 膜 6 b を 成 膜 する ことができる。 これを M り返し行ない、 膜 6 a と 膜 6 b が それ で れ 50 Å の 厚 さとなるように 交 互 に 放 膜 横 博 する ことにより バッファ 層 6 が 得られる。

内に交互に積み重ねるように成級した非磁性金融版 6 a とセラミックス版 6 b との機 倍数とし、それぞれの E 気配線媒体について 10 点 測定した平均値をプロットしたものである。 第 2 図 回は、 疑軸を媒体の代没的な E 女 数 である 要 留 E 東密度 Br と、 E と E は A の 版 F と B について、 80 の R H 乗 境 内に 放 壁 した 1 ヶ月 耐 食 性 試 験 後 の 被 少 率 ム Br・ B と し、 砂 軸 は 第 2 図 回 と 同 様 版 E 6 a と 版 6 b の 報 層 数 を 要 わ し、 ブロット は 同 じく 10 点 行なって 平均値 を 用 いた。

第2図(a),(b)ともに、本強明によるバッファ尼 6を形成するのにブラスチックを収を用いたもの (○), 同じくブラスチック複合材の基板を用い たもの(○), 比較のためのブラスチック癌板を用 いた非価性金属膜 6 a 単独のもの(本) およびセラ ミックス膜 6 b 単独のもの(×)を併記してある。

第2図回,10の両図を参照すればわかるように、パッファ層 6 が単一材料の一層のみでは 00 6 a 。 膜 6 b のいずれの場合も、 Cr 下地間 3 に 100 個以上のクラックが発生し、それが原因となって ABr・ 8 値は 5 %以上に逆する。 このことは単一材料の場合この 突施例の範囲で膜厚を変化させても同じである。 △Br・ β 値が 5 %以上になると 歴気記録 供体の記録・ 再生の 繰り返しによるエラーが増加するので、 バッファ暦 6 としては単一材料のみで形成するのが 適当でないことは明らかである。

ぞれの界面で吸収または設和するように働き、その結果金属下地層 3 の Cr にクラックが発生するのを防止することができる。

そのほか本発明の磁気記録媒体は基板にブラスチックまたはその複合材料を用いているために、 従来の A&-Mg 合金 越 仮より約60 % 軽量になると ともに、複雑な研磨工程を必要とせず、 遊板上に 地積させる各層は本発明に係るパッファ階も含め て同一反応 僧内で順次スパッタさせればよいとい う利点もある。

(発明の効果)

無気配鉄媒体は軽量にするとともに、コストの低級が望まれており、加工工数の多い従来の A& 合金番板に代って、後加工なしで高い表面精度の たとえ来軟性をもつまれる。 でもこれを単独にパッファ暦 6 として用いるときは、その腰厚は 1000 Å以上を必要とすると考えられるが、本発明では非研性金銭膜 6 a ともうを成したために、 原 6 a と膜 6 b の 厚さがいずれも 50 Åであるから、 10 層重ねたとしてなる。 なおの 履 6 の 膜厚は 500 Åで足りることになる。 なお 3 で との は 500 Åで足りることになる。 なお 3 で とにより、 A&, Si, Ti, V, W などを放 で 5 で といてき、 セラミックス 膜 6 b も 同様に SiC の はかに SiO, SiO2, Si, N4, TiC, TaC, B, C, W C, BN などの 成膜が 可能であり、 これらの 膜が 可能であり、 これらの 次 6 は 4 なる。

得られるプラスチックまたはその敬合材料を用い ることができるが、これらブラスチック糸材料の 悲板は、その上に形成される金属下地層(Cr)と 悪膨張係数が大きく異なるため、 成膜後の金禺下 地層にクラックを発生し、このことが原因となっ て媒体の射貨性能が発しく低下する。これに対し て本発明の無気配象媒体は実施例で述べたように、 プラスチック系密板と金属膜との間に非風性金属 既とセラミックス 膜とを交互に 積み 取ねたパッフ ァ順を介在させるようにしたため、 基板と金属膜 の無膨張係数の差により生ずる内部応力を、楔層 されたそれぞれの腹の界面で吸収または凝和する ように分担するととが可能となり、これが単一材 科のパッファ層では不可能であった 500 Å以下の 膜厚のパッファ眉で応力緩和を実現させ、その結 果金以下地脂にクラックが発生するのを防ぐこと ができる。

以上のことから、本発明の母気配録媒体はアル ミニウム系基板を用いたときに起きる本質的な欠 点を排除し、 佐来の A.B 白金基板を用いた媒体と 问機の射食性能および信頼性を維持するものである。

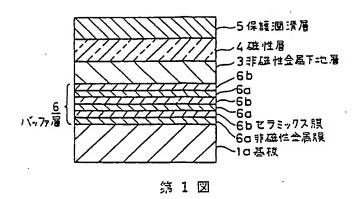
4. 図面の簡単な説明

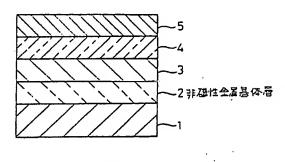
第1図は本発明の磁気記録媒体の要部構成を示す模式断面図、第2図回は本発明の磁気記録媒体のバッファ層内の機層数と非磁性金旗下地層に生するクラック数との関係観図、第2図回は同じくバッファ層内の機層数とABr・カとの関係観図、第3図は従来の磁気記录媒体の要部構成を示す模式断面図である。

1,1a… 基板、2… 非磁性金属基体層、3…非磁性金属下地層、4 … 磁性層、5 … 保護調付層、6 … パッファ 層、6 a … 非磁性金属膜、6 b … セラミックス膜。

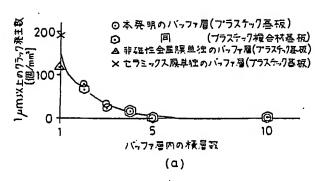
代证人并证士 山 口 五

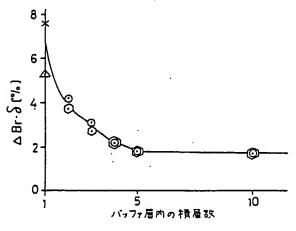






第 3 図





(b) 第 2 図